

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第6378372号
(P6378372)

(45) 発行日 平成30年8月22日 (2018. 8. 22)

(24) 登録日 平成30年8月3日 (2018. 8. 3)

(51) Int. Cl.		F I			
HO 1 L	21/336	(2006. 01)	HO 1 L	29/78	6 2 7 D
HO 1 L	29/786	(2006. 01)	HO 1 L	29/78	6 1 2 Z
GO 2 F	1/1368	(2006. 01)	GO 2 F	1/1368	
GO 9 F	9/00	(2006. 01)	GO 9 F	9/00	3 3 8
GO 9 F	9/30	(2006. 01)	GO 9 F	9/30	3 3 8

請求項の数 2 (全 27 頁)

(21) 出願番号 特願2017-5614 (P2017-5614)
 (22) 出願日 平成29年1月17日 (2017. 1. 17)
 (62) 分割の表示 特願2016-202694 (P2016-202694)
 の分割
 原出願日 平成12年7月17日 (2000. 7. 17)
 (65) 公開番号 特開2017-108147 (P2017-108147A)
 (43) 公開日 平成29年6月15日 (2017. 6. 15)
 審査請求日 平成29年2月14日 (2017. 2. 14)

(73) 特許権者 000153878
 株式会社半導体エネルギー研究所
 神奈川県厚木市長谷398番地
 (72) 発明者 山崎 舜平
 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社
 半導体エネルギー研究所内
 (72) 発明者 高山 徹
 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社
 半導体エネルギー研究所内

審査官 棚田 一也

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体装置の作製方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板上に有機物を介してポリイミド層が位置する構造体を形成し、
前記ポリイミド層上に、トランジスタを形成し、
前記トランジスタ上に液晶材料を設け、
前記液晶材料を設けた後に、レーザー光を前記基板側から前記有機物に照射することにより、前記基板を分離し、
前記基板は、前記ポリイミド層よりも高い耐熱性があることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項2】

基板上に有機物を介してポリイミド層が位置する構造体を形成し、
前記ポリイミド層上に、トランジスタを形成し、
前記トランジスタ上に液晶材料を設け、
前記液晶材料を設けた後に、線状レーザー光を前記基板側から前記有機物に照射することにより、前記基板を分離し、
前記基板は、前記ポリイミド層よりも高い耐熱性があることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本願発明は薄膜トランジスタ（以下、TFTという）で構成された回路を有する半導体装置およびその作製方法に関する。例えば、液晶表示パネルに代表される電気光学装置およびその様な電気光学装置を部品として搭載した電子機器に関する。

【0002】

なお、本明細書中において半導体装置とは、半導体特性を利用することで機能しうる装置全般を指し、電気光学装置、半導体回路および電子機器は全て半導体装置である。

【背景技術】

【0003】

近年、絶縁表面を有する基板上に形成された半導体薄膜（厚さ数～数百nm程度）を用いて薄膜トランジスタ（TFT）を構成する技術が注目されている。薄膜トランジスタはICや電気光学装置のような電子デバイスに広く応用され、特に画像表示装置のスイッチング素子として開発が急がれている。

10

【0004】

このような画像表示装置を利用したアプリケーションは様々なものが期待されているが、特に携帯機器への利用が注目されている。そのため、フレキシブルなプラスチックフィルムの上にTFT素子を形成することが試みられている。

【0005】

しかしながら、プラスチックフィルムの耐熱性が低いためプロセスの最高温度を低くせざるを得ず、結果的にガラス基板上に形成する時ほど良好な電気特性のTFTを形成できないのが現状である。そのため、プラスチックフィルムを用いた高性能な液晶表示装置は実現されていない。

20

【0006】

また、特開平8-288522号公報では、ガラス基板上に薄膜トランジスタを形成し、封止層を介して樹脂基板を接着した後、ガラス基板を剥離する技術が記載されている。この技術を用いた場合、TFTの活性層が下地絶縁膜で保護されるのみとなっており、TFTが劣化しやすいという問題が生じていた。

【0007】

また、特開平11-243209号公報では、分離層を設け、レーザー光によって分離層において剥離を生じせしめた後、接着層を介して一次転写体に接合し、さらに接着層を介して二次転写体を接合した後、一次転写体を除去する技術が記載されている。この技術を用いた場合においても、TFTの活性層が下地絶縁膜のみで保護される状態が作製工程中に存在するため、傷つきやすくなっており、TFTが劣化しやすいという問題が生じていた。

30

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

本願発明はプラスチック支持体（可撓性のプラスチックフィルムもしくはプラスチック基板を含む。）を用いて高性能な電気光学装置を作製するための技術を提供することを課題とする。

【課題を解決するための手段】

40

【0009】

本願発明は、プラスチックに比べて耐熱性のある第1固定基板の上にプラスチック支持体からなる素子形成基板を第1接着層で接着した後、該素子形成基板上に必要な素子を形成し、該素子上に第2固定基板を第2接着層で貼り合わせた後に液晶材料を封止保持した後、第1固定基板を分離することを特徴とする。

【0010】

なお、前記必要な素子とは、アクティブマトリクス型の電気光学装置ならば画素のスイッチング素子として用いる半導体素子（典型的にはTFT）もしくはMIM素子を指す。

【0011】

また、第1固定基板と素子形成基板との貼り合わせ方法は、特に限定されないが、図1

50

に示したように、第1固定基板に第1接着層を形成した後で素子形成基板を貼り合わせる方法、あるいは素子形成基板に第1接着層を形成した後で第1固定基板を貼り合わせる方法を用いればよい。

【0012】

また、プラスチック支持体からなる素子形成基板及び第2固定基板としては厚さ10 μ m以上の樹脂基板、例えばPES（ポリエチレンサルファイル）、PC（ポリカーボネート）、PET（ポリエチレンテレフタレート）もしくはPEN（ポリエチレンナフタレート）を用いることができる。なお、第1の固定基板上に接着層を形成した後、その上に有機樹脂層（ポリイミド層、ポリアミド層、ポリイミドアミド層、BCB（ベンゾシクロブテン）層等）を成膜したものを素子形成基板と呼んでもよい。

10

【0013】

また、素子形成基板としては、金属基板、例えばステンレス基板を用いることもできる。その場合は金属基板上に下地絶縁膜を形成して必要な素子を形成すればよい。薄い金属基板（厚さ10～200 μ m）を用いることによって軽量化、薄型化が図れるとともに可撓性を有する反射型の液晶表示装置を得ることができる。

【0014】

また、第1固定基板を分離するのは、素子形成基板上に必要な素子を形成し、第2固定基板を貼り合わせた後に行うが、その手段としてレーザー光の照射により第1接着層の全部または一部を気化させる方法を用いる。また、レーザー光の照射に代えて、例えば、特開平8-288522号公報に記載されたエッチングにより第1固定基板を分離する方法や、第1接着層に対して流体（圧力が加えられた液体もしくは気体）を噴射することにより第1固定基板を分離する方法（代表的にはウォータージェット法）を用いてもよいし、これらを組み合わせて用いてもよい。

20

【0015】

レーザー光としては、パルス発振型または連続発光型のエキシマレーザーやYAGレーザー、YVO₄レーザーを用いることができる。図3(D)に示すようにレーザー光を裏面側から第1固定基板を通過させて第1接着層を照射して第1接着層のみを気化させて第1固定基板を分離もしくは剥離する。従って、第1固定基板としては少なくとも照射するレーザー光が通過する基板、代表的には透光性を有する基板、例えばガラス基板、石英基板等を用い、さらに素子形成基板よりも厚さの厚いものが好ましい。

30

【0016】

本発明においては、レーザー光が第1固定基板を通過させるため、レーザー光の種類と第1固定基板を適宜選択する必要がある。例えば、第1固定基板として石英基板を用いるのであれば、YAGレーザー（基本波（1064nm）、第2高調波（532nm）、第3高調波（355nm）、第4高調波（266nm））あるいはエキシマレーザー（波長308nm）を用い、線状ビームを形成し、石英基板を通過させればよい。なお、エキシマレーザーはガラス基板を通過しない。従って、第1固定基板としてガラス基板を用いるのであればYAGレーザーの基本波、第2高調波、または第3高調波を用い、好ましくは第2高調波（波長532nm）を用いて線状ビームを形成し、ガラス基板を通過させればよい。

40

【0017】

また、第1接着層としては有機物を用い、好ましくは照射するレーザー光で全部または一部が気化するものを用いる。また、効率よく第1接着層のみにレーザー光を吸収させるために、第1接着層がレーザー光を吸収する特性を有するもの、例えば、YAGレーザーの第2高調波を用いる場合、有色、あるいは黒色（例えば、黒色着色剤を含む樹脂材料）のものを用いることが望ましい。ただし、第1接着層は素子形成工程における熱処理によって気化しないものを用いる。また、第1接着層は単層であっても積層であってもよく、図2に示したように第1接着層と素子形成基板の間にアモルファスシリコン膜またはDLC膜を設ける構成としてもよい。

【0018】

50

このような構成とすることによって、素子形成基板の厚さが非常に薄い、具体的には $50\ \mu\text{m} \sim 300\ \mu\text{m}$ 、好ましくは $150\ \mu\text{m} \sim 200\ \mu\text{m}$ の厚さの基板を用いても、信頼性の高い液晶表示装置を得ることができる。また、従来ある公知の製造装置を用いて、このように厚さの薄い基板の上に素子形成を行うことは困難であったが、本発明は第1固定基板に貼り合わせて素子形成を行うため、装置の改造を行うことなく厚さの厚い基板を用いた製造装置を使用することができる。また、素子形成工程中において、素子形成基板を素子形成基板の上に形成される絶縁膜と、第1固定基板とで挟まれた状態とすることで素子形成基板の耐熱性を向上させることができる。

【0019】

本明細書で開示する発明の構成は、第1固定基板と素子形成基板とを該素子形成基板に設けられた第1接着層で貼り合わせ、該素子形成基板を貼り合わせた後に絶縁膜を形成し、該絶縁膜の上にTFT素子及び画素電極を形成し、該画素電極の上に第2接着層で第2固定基板を貼り合わせた後、レーザー光の照射により前記第1接着層を除去して前記第1固定基板を分離することを特徴とする半導体装置の作製方法である。

10

【0020】

また、他の発明の構成は、第1固定基板と素子形成基板とを前記固定基板に設けられた第1接着層で貼り合わせ、該素子形成基板を貼り合わせた後に絶縁膜を形成し、該絶縁膜の上にTFT素子及び画素電極を形成し、該画素電極の上に第2接着層で第2固定基板を貼り合わせた後、レーザー光の照射により前記第1接着層を除去して前記第1固定基板を分離することを特徴とする半導体装置の作製方法である。

20

【0021】

上記各構成において、前記画素電極と前記第2固定基板との間に液晶材料を備え、前記液晶材料は、前記素子形成基板と前記第2固定基板とを貼り合わせる前記第2接着層（シール材等）で保持することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【0022】

また、上記各構成において、前記素子形成基板と第1接着層の間には、非晶質シリコン薄膜を形成してもよい。また、前記素子形成基板と第1接着層の間には、ダイヤモンド状炭素薄膜を形成してもよい。

【0023】

また、上記各構成において、前記第1接着層は、顔料や染料を用いて有色または黒色としてレーザー光を吸収するようにしてもよい。

30

【0024】

上記各構成において、前記素子形成基板及び前記第2固定基板は有機樹脂からなる支持体（可撓性のプラスチックフィルムもしくはプラスチック基板を含む）であることを特徴としている。また、前記素子形成基板及び前記第2固定基板としては、第1固定基板と比べて厚さの薄いものを用いる。

【0025】

また、上記各構成において、前記レーザー光の照射は、線状ビームを形成して走査させて照射することを特徴としており、前記レーザー光は、パルス発振型または連続発光型のエキシマレーザーや、YAGレーザーや、YVO₄レーザーを用いることができる。

40

【0026】

また、上記各構成において、前記レーザー光の照射は、前記第1固定基板の裏面側から前記第1固定基板を通過させて、前記第1固定基板の表面側に設けられた前記第1接着層に前記レーザー光を照射することを特徴としている。従って、前記第1固定基板は、使用するレーザー光を透過することが好ましい。

【0027】

また、上記各構成に記載された半導体装置とは、透過型の液晶表示装置または反射型の液晶表示装置であることを特徴としている。

【発明の効果】**【0028】**

50

本発明により樹脂基板である素子形成基板と樹脂基板である第2固定基板とで素子形成層（液晶材料、画素電極、およびTFT素子含む）を挟んだ表示装置は、多少の応力が発生しても破損しない柔軟性（フレキシビリティ）を有している。

【0029】

また、素子形成基板の厚さが非常に薄い、具体的には50 μ m～300 μ m、好ましくは150 μ m～200 μ mの厚さの基板を用いても、信頼性の高い液晶表示装置を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【0030】

【図1】基板貼り合わせ工程を示す図。

10

【図2】貼り合わせた基板の状態を示す図。

【図3】作製工程を示す図。

【図4】pチャンネル型TFTの作製工程を示す図。

【図5】nチャンネル型TFTの作製工程を示す図。

【図6】CMOS回路を作製する工程を説明する図。

【図7】CMOS回路を作製する工程を説明する図。

【図8】NMOS回路の構成を示す図。

【図9】シフトレジスタの構成を示す図。

【図10】液晶表示装置の駆動回路及び画素部の断面構造図。

【図11】液晶表示装置の上面図。

20

【図12】液晶表示装置の画素の上面図。

【図13】液晶表示装置の回路ブロック図。

【図14】液晶表示装置の画素部の上面図および断面構造図。

【図15】液晶表示装置の駆動回路及び画素部の断面構造図。

【図16】液晶表示装置の駆動回路及び画素部の断面構造図。

【図17】曲率を与えた状態を示す図。

【図18】電子機器の一例を示す図。

【図19】電子機器の一例を示す図。

【発明を実施するための形態】

【0031】

30

本願発明の実施形態について、以下に説明する。

【0032】

まず、第1固定基板101と素子形成基板103とを貼り合わせるが、図1に示したように2通りの貼り合わせ方法がある。

【0033】

一つ目の方法は、第1固定基板101上に第1接着層102を設けた後、第1固定基板101と素子形成基板103とを貼り合わせる方法である。（図1（A1））なお、貼り合わせ後の状態を図1（B1）に示した。

【0034】

また、二つ目の方法は、素子形成基板103に第1接着層102を設けた後、第1固定基板101と素子形成基板103とを貼り合わせる方法である。（図1（A2））なお、貼り合わせ後の状態を図1（B2）に示した。

40

【0035】

また、ここでは図示しないが、第1固定基板上に第1接着層を形成した後、その上に有機樹脂層（ポリイミド層、ポリアミド層、ポリイミドアミド層等）を成膜したものを素子形成基板と同等なものとしてもよい。

【0036】

また、図2（A）に示したように、第1接着層202Bと素子形成基板203の間にaSi（アモルファスシリコン）層202Aを設ける構成としてもよい。後の工程で、このaSi層にレーザー光を照射することにより第1固定基板201を剥離させてもよい

50

。第1固定基板201が分離または剥離しやすいようにするため水素を多く含むa Si層を用いることが好ましい。レーザー光を照射することによりa Si層に含まれる水素を気化させて第1固定基板を分離または剥離する。

【0037】

また、図2(B)に示したように、第1接着層205Bと素子形成基板206の間に、素子形成基板206を保護するためのDLC膜(具体的にはダイヤモンドライクカーボン膜)を設けてもよい。なお、第1固定基板204は、図1中に示した第1固定基板101と同一である。

【0038】

この場合、素子形成基板の片面もしくは両面に保護膜としてDLC膜を膜厚2~50nmでコーティングしたものをを用いてもよい。なお、DLC膜の成膜はスパッタ法もしくはECRプラズマCVD法を用いればよい。DLC膜の特徴としては、 1550 cm^{-1} くらいに非対称のピークを有し、 1300 cm^{-1} くらいに肩をもつラマンスペクトル分布を有する。また、微小硬度計で測定した時に15~25GPaの硬度を示すという特徴をもつ。このような炭素膜は、酸素および水の侵入を防ぐとともに樹脂基板の表面を保護する役割を持つ。こうして、外部からの水分や酸素等による劣化を促す物質が侵入することを防ぐことができる。従って、信頼性の高い液晶表示装置が得られる。

【0039】

また、図2(C)に示したように、第1接着層208Cと素子形成基板209の間に、素子形成基板を保護するための第1DLC膜208Aと、第1固定基板207が分離または剥離しやすいようにするための第2DLC膜208Bを設けてもよい。このような第1DLC膜208Aとしては水素を含まない成膜条件で成膜したものをを用い、第2DLC膜208Bとしては水素を含む成膜条件で成膜したものをを用いればよい。また、第2DLC膜208Bにレーザー光を照射することにより膜中に含まれる水素を気化させて第1固定基板207を分離または剥離させてもよい。

【0040】

上記各方法によって得られる貼り合わせ後の状態を図3(A)に示した。ここでは、図1(B1)及び図1(B2)と同一のものを例示する。なお、符号は図1(B1)及び図1(B2)と同じ符号を用いた。

【0041】

次いで、素子形成基板103上に下地絶縁膜を形成した後、その下地絶縁膜上に必要な素子を形成する。ここでは、駆動回路104とTF T素子及び画素電極を有する画素部105を形成した例を示す。(図3(B))

【0042】

次いで、第2固定基板(対向基板)106を第2接着層(シール材)107で貼り合わせる。(図3(C))次ぎに液晶材料108を封止保持する。第2固定基板106としては、樹脂基板を用いればよく、片面もしくは両面に保護膜としてDLC膜を設けたものをを用いてもよい。

【0043】

次いで、裏面側からレーザー光を照射して第1接着層102の全部または一部を気化させて第1固定基板101を分離する。(図3(D))従って、第1接着層102はレーザー光によって層内または界面において剥離現象が生じる物質を用いる。また、レーザー光は第1固定基板101を通過して第1接着層で吸収するものを適宜選択する。例えば、第1固定基板として石英基板を用いるのであれば、YAGレーザー(基本波(1064nm)、第2高調波(532nm)、第3高調波(355nm)、第4高調波(266nm))あるいはエキシマレーザー(波長308nm)を用い、線状ビームを形成し、石英基板を通過させればよい。なお、エキシマレーザーはガラス基板を通過しない。従って、第1固定基板としてガラス基板を用いるのであればYAGレーザーの基本波、第2高調波、第3高調波を用いることができ、好ましくは第2高調波(波長532nm)を用いて線状ビームを形成し、ガラス基板を通過させればよい。

10

20

30

40

50

【0044】

なお、レーザー照射して第1固定基板を分離する工程は、第2固定基板を貼り合わせた後に行えばよく、液晶の注入、封止の前に行ってもよい。

【0045】

そして、最終的には、樹脂基板である素子形成基板と樹脂基板である第2固定基板とで液晶材料が挟まれた液晶表示装置が完成する。

【0046】

また、図17に示したように、樹脂基板である素子形成基板103と樹脂基板である第2固定基板106とで素子形成層(液晶材料、画素電極、及びTFT素子を含む)を挟んだ液晶表示装置は、多少の応力が発生しても破損しない柔軟性(フレキシビリティ)を有している。図17(A)は曲率を与えていないときの状態を示し、図17(B)は曲率を与えたときの状態を示す。図17(B)において、素子形成基板には圧縮応力が働き、第2固定基板には引張応力が働くが、素子形成層においては、応力がほとんど働かず、中央部における伸び縮みを $\pm 1 \mu\text{m}$ 以下とすることができる。なお、曲率半径が10cmまでの曲率を与えても問題ない。

10

【0047】

以上の構成でなる本願発明について、以下に示す実施例でもってさらに詳細な説明を行うこととする。

【実施例1】

【0048】

本実施例は、樹脂基板である素子形成基板と樹脂基板である第2固定基板とで液晶材料が挟まれた液晶表示装置の作製方法の一例を図3を用いて示す。なお、ここでは、全ての工程を350以下、好ましくは200以下で行うこととする。ただし、本発明が本実施例に限定されないことはいうまでもない。

20

【0049】

まず、第1固定基板101としてガラス基板を用いる。そして、実施の形態に示したいずれかの方法を用いて、第1固定基板101と樹脂基板である素子形成基板103とを第1接着層102で貼り合わせた。(図3(A))

【0050】

次いで、素子形成基板103上に下地絶縁膜を形成した後、その下地絶縁膜上に必要な素子を形成する。ここでは、駆動回路104とTFT素子及び画素電極を有する画素部105を形成した例を示す。(図3(B))

30

【0051】

下地絶縁膜としては、低温で成膜が可能なスパッタ法を用いて、膜組成において酸素元素より窒素元素を多く含む酸化窒化シリコン膜と、膜組成において窒素元素より酸素元素を多く含む酸化窒化シリコン膜を積層形成した。

【0052】

次いで、下地絶縁膜上に半導体層を形成する。半導体層の材料に限定はないが、好ましくはシリコンまたはシリコンゲルマニウム($\text{Si}_x\text{Ge}_{1-x}$ ($0 < x < 1$))合金などで形成すると良い。本実施例では、低温で成膜が可能なスパッタ法を用いて非晶質シリコン膜を形成し、レーザー結晶化法により結晶質シリコン膜を形成した。レーザー結晶化法で結晶質半導体膜を作製する場合には、パルス発振型または連続発光型のエキシマレーザーやYAGレーザー、YVO₄レーザーを用いることができる。

40

【0053】

次いで、半導体層を覆うゲート絶縁膜を形成する。本実施例では、低温で成膜が可能なスパッタ法を用いて酸化シリコン膜を形成した。

【0054】

次いで、ゲート絶縁膜上に導電層を形成する。導電層は、導電膜を公知の手段(熱CVD法、プラズマCVD法、減圧熱CVD法、蒸着法、またはスパッタ法等)により成膜した後、マスクを用いて所望の形状にパターニングして形成する。

50

【0055】

次いで、イオン注入法またはイオンドーピング法を用い、半導体層にn型を付与する不純物元素またはp型を付与する不純物元素を適宜、添加してLDD領域やソース領域やドレイン領域を形成する不純物領域を形成する。

【0056】

その後、スパッタ法により作製される窒化シリコン膜、窒化酸化シリコン膜、または酸化シリコン膜により層間絶縁膜を形成する。また、添加された不純物元素は活性化処理を行う。ここでは、レーザー光の照射を行った。レーザー光の照射に代えて、350 以下の加熱処理で活性化を行ってもよい。

【0057】

次いで、公知の技術を用いてソース領域またはドレイン領域に達するコンタクトホールを形成した後、ソース電極またはドレイン電極を形成しTFTを得る。

【0058】

次いで、公知の技術を用いて水素化処理を行い、全体を水素化してnチャネル型TFTまたはpチャネル型TFTが完成する。本実施例では比較的低温で行うことが可能な水素プラズマを用いて水素化処理を行った。

【0059】

次いで、スパッタ法により作製される窒化シリコン膜、窒化酸化シリコン膜、または酸化シリコン膜により層間絶縁膜を形成する。次いで、公知の技術を用いて画素部のドレイン電極に達するコンタクトホールを形成した後、ITO、SnO₂等の透明導電膜からなる画素電極を形成する。本実施例では一例として透過型の液晶表示装置の例を示したが特に限定されない。例えば、画素電極の材料として反射性を有する金属材料を用い、画素電極のパターニングの変更、または幾つかの工程の追加/削除を適宜行えば反射型の液晶表示装置を作製することが可能である。

【0060】

次いで、画素部及び駆動回路に含まれる素子を全て絶縁膜（配向膜等）で覆う。

【0061】

次いで、素子形成基板に形成された素子を全て覆う絶縁膜と第2固定基板106とを第2接着層（シール材）107で貼り合わせる。この後、液晶材料を注入して封止する。（図3（C））第2固定基板106としては、樹脂基板を用いればよく、片面もしくは両面に保護膜としてDLC膜を設けたものを用い、対向電極と、液晶を配向させるための配向膜を備えている。

【0062】

次いで、裏面側からレーザー光を照射して第1接着層102の全部または一部を気化させて第1固定基板101を分離する。（図3（D））本実施例では、第1固定基板としてガラス基板を用いるため、YAGレーザーの基本波、第2高調波、第3高調波を用いる。ここでは第2高調波（波長532nm）を用いて線状ビームを形成し、第1固定基板101であるガラス基板を通過させて第1接着層を照射した。

【0063】

そして、最終的には、樹脂基板である素子形成基板と樹脂基板である第2固定基板とで液晶材料を保持した液晶表示装置が完成した。スパッタ法を用いて各膜（絶縁膜、半導体膜、導電膜等）を形成し、全てのプロセスを350 以下、好ましくは200 以下で行うことができる。

【実施例2】

【0064】

本実施例は、pチャネル型TFTを作製する例であり、図4を用いて説明する。

【0065】

まず、第1固定基板401と第1接着層402（分離層）で貼りつけた素子形成基板403上に下地絶縁膜404を形成する。下地絶縁膜404としては、酸化シリコン膜、窒化シリコン膜、窒化酸化シリコン膜（SiO_xN_y）、またはこれらの積層膜等を100

10

20

30

40

50

~ 500 nmの膜厚範囲で用いることができ、形成手段としては熱CVD法、プラズマCVD法、蒸着法、スパッタ法、減圧熱CVD法等の形成方法を用いることができる。

【0066】

本実施例では、低温で成膜が可能なスパッタ法を用いて、膜組成において酸素元素より窒素元素を多く含む酸化窒化シリコン膜と、膜組成において窒素元素より酸素元素を多く含む酸化窒化シリコン膜を積層形成した。

【0067】

なお、第1固定基板401と第1接着層402(分離層)で貼りつけた素子形成基板403は上記実施形態で示した方法により作製されるいずれのものも適用可能である。

【0068】

次いで、下地絶縁膜上に半導体層405を形成する。半導体層405は、非晶質構造を有する半導体膜を公知の手段(熱CVD法、プラズマCVD法、減圧熱CVD法、蒸着法、またはスパッタ法等)により成膜した後、公知の結晶化処理(レーザー結晶化法、熱結晶化法、またはニッケルなどの触媒を用いた熱結晶化法等)を行って得られた結晶質半導体膜を所望の形状にパターニングして形成する。この半導体層405の厚さは20~100 nm(好ましくは30~60 nm)の厚さで形成する。結晶質半導体膜の材料に限定はないが、好ましくはシリコンまたはシリコンゲルマニウム(Si_xGe_{1-x} ($0 < x < 1$))合金などで形成すると良い。本実施例では、低温で成膜が可能なスパッタ法を用いて非晶質シリコン膜を形成し、レーザー結晶化法により結晶質シリコン膜を形成した。レーザー結晶化法で結晶質半導体膜を作製する場合には、パルス発振型または連続発光型のエキシマレーザーやYAGレーザー、YVO₄レーザーを用いることができる。

【0069】

また、半導体層405を形成した後、TFTのしきい値を制御するために微量な不純物元素(ボロンまたはリン)のドーピングを行ってもよい。

【0070】

次いで、半導体層405を覆うゲート絶縁膜406を形成する。ゲート絶縁膜406はプラズマCVD法またはスパッタ法を用い、厚さを40~150 nmとしてシリコンを含む絶縁膜で形成する。本実施例では、低温で成膜が可能なスパッタ法を用いて酸化シリコン膜を形成した。(図4(A))

【0071】

次いで、ゲート絶縁膜406上に導電層408を形成する。導電層408は、導電膜を公知の手段(熱CVD法、プラズマCVD法、減圧熱CVD法、蒸着法、またはスパッタ法等)により成膜した後、マスク407を用いて所望の形状にパターニングして形成する。導電層408の材料としては、Ta、W、Ti、Mo、Al、Cu、Cr、Ndから選ばれた元素、または前記元素を主成分とする合金材料若しくは化合物材料で形成してもよい。また、リン等の不純物元素をドーピングした多結晶シリコン膜に代表される半導体膜を用いてもよい。また、AgPdCu合金を用いてもよい。本実施例では、低温で成膜が可能なスパッタ法を用いてW膜を成膜し、パターニングした。導電層408の端部はテーパ状に形成する。エッチング条件は適宜決定すれば良いが、例えば、Wの場合にはCF₄とCl₂の混合ガスを用い、基板を負にバイアスすることにより良好にエッチングすることができる。

【0072】

次いで、図4(B)に示すように、自己整合的にソース及びドレイン領域を形成する不純物領域(p+領域)409を形成する。この不純物領域(p+領域)409はイオンドープ法により形成し、ボロンに代表される周期律表第13族の元素をドーピングする。不純物領域(p+領域)409の不純物濃度は、 $1 \times 10^{20} \sim 2 \times 10^{21} / \text{cm}^3$ の範囲となるようにする。

【0073】

次に、図4(C)に示すように導電層408の端部が後退するようにエッチングして導電層410を形成する。本実施例の構造ではこれをゲート電極とする。

10

20

30

40

50

ゲート電極の形成には2回のエッチング工程を用いるが、そのエッチング条件は適宜決定されるものである。例えば、Wの場合には CF_4 と Cl_2 の混合ガスを用い、基板を負にバイアスすることにより良好に端部がテーパ形状に加工することができる。また、 CF_4 と Cl_2 に酸素を混合させることにより、下地と選択性良く、Wの異方性エッチングエッチングをすることができる。

【0074】

その後、図4(D)に示すように、導電層410をマスクとしてp型の不純物(アクセプタ)をドーピングし、自己整合的に不純物領域(p-領域)411を形成する。不純物領域(p-領域)411の不純物濃度は、 $1 \times 10^{17} \sim 2 \times 10^{19} / cm^3$ の範囲となるようにする。

10

【0075】

その後、スパッタ法またはプラズマCVD法により作製される窒化シリコン膜、窒化酸化シリコン膜により層間絶縁膜413を形成する。また、添加された不純物元素は活性化のために350~500の加熱処理またはレーザー光の照射を行う。さらに、公知の技術を用いて不純物領域(p+領域)に達するコンタクトホールを形成した後、ソース電極またはドレイン電極414を形成しTFETを得る。

【0076】

最後に公知の技術を用いて水素化処理を行い、全体を水素化してpチャネル型TFETが完成する。(図4(E))本実施例では比較的低温で行うことが可能な水素プラズマを用いて水素化処理を行った。

20

【0077】

半導体層にはチャネル形成領域412、不純物領域(p-領域)で形成されるLDD(Lightly Doped Drain)領域411、不純物領域(p+領域)で形成されるソースまたはドレイン領域409が形成されている。ここでは、pチャネル型TFETをLDD構造で示したが、勿論シングルドレインや、或いはLDDがゲート電極とオーバーラップした構造で作製することもできる。本実施例で示すpチャネル型TFETを用いて基本論理回路を構成したり、さらに複雑なロジック回路(信号分割回路、D/Aコンバータ、オペアンプ、補正回路など)をも構成することができ、さらにはメモリやマイクロプロセッサをも形成しうる。例えば、液晶表示装置の駆動回路を全てpチャネル型TFETで構成することも可能である。

30

【0078】

また、本実施例は実施例1と組み合わせることが可能である。

【実施例3】

【0079】

本実施例は、nチャネル型TFETを作製する例であり、図5を用いて説明する。なお、図4(A)と図5(A)は同一であるため、同じ符号を用い、ここでは作製工程の説明を省略する。

【0080】

実施例2に従って図5(A)の状態を得た後、光露光プロセスによりレジストによるマスク415を形成し、半導体膜405にイオン注入またはイオンドーブ法によりn型の不純物(ドナー)をドーピングする。(図5(B))作製される不純物領域(n-領域)416において、ドーピングされる濃度は $1 \times 10^{17} \sim 2 \times 10^{19} / cm^3$ の範囲となるようにする。

40

【0081】

次いで、絶縁膜406上には、タンタル、タングステン、チタン、アルミニウム、モリブデンから選ばれた一種または複数種の元素を成分とする導電性材料でゲート電極417を形成する。(図5(C))ゲート電極417の一部は不純物領域(n-領域)416とゲート絶縁膜を介して一部が重なるように形成する。

【0082】

その後、図5(D)に示すように、ゲート電極417をマスクとしてn型の不純物(ド

50

ナー)をドーピングし、自己整合的に不純物領域(n+領域)418を形成する。不純物領域(n+領域)418の不純物濃度は、 $1 \times 10^{17} \sim 2 \times 10^{19} / \text{cm}^3$ の範囲となるようにする。

【0083】

その後、プラズマCVD法により作製される窒化シリコン膜、窒化酸化シリコン膜により層間絶縁膜419を形成する。また、添加された不純物元素は活性化のために350～500の加熱処理またはレーザー光の照射を行う。さらに、公知の技術を用いて不純物領域(n+領域)に達するコンタクトホールを形成した後、ソース電極またはドレイン電極420を形成しTFETを得る。

【0084】

最後に公知の技術を用いて水素化処理を行い、全体を水素化してnチャネル型TFETが完成する。(図5(E))本実施例では比較的低温で行うことが可能な水素プラズマを用いて水素化処理を行った。

【0085】

半導体層にはチャネル形成領域419、不純物領域(n-領域)で形成されるLDD(Lightly Doped Drain)領域416、不純物領域(n+領域)で形成されるソースまたはドレイン領域418が形成されている。また、LDD領域416はゲート電極417とオーバーラップして形成され、ドレイン端における電界の集中を緩和して、ホットキャリアによる劣化を防いでいる。勿論シングルドレインや、LDD構造でnチャネル型TFETを作製することもできる。本実施例で示すnチャネル型TFETを用いて基本論理回路を構成したり、さらに複雑なロジック回路(信号分割回路、D/Aコンバータ、オペアンプ、補正回路など)をも構成することができ、さらにはメモリやマイクロプロセッサをも形成しうる。

例えば、液晶表示装置の駆動回路を全てnチャネル型TFETで構成することも可能である。

【0086】

また、本実施例は実施例1と組み合わせることが可能である。

【実施例4】

【0087】

本実施例は、nチャネル型TFETとpチャネル型TFETとを相補的に組み合わせたCMOS回路を作製する例であり、図6、図7を用いて説明する。

【0088】

実施例2に従って、第1固定基板と第1接着層(分離層)で貼りつけた素子形成基板上に下地絶縁膜を形成した後、半導体層501、502を形成する。(図6(A))

【0089】

次いで、スパッタ法によりゲート絶縁膜503と第1導電膜504と第2導電膜505を形成する。(図6(B))本実施例では、第1導電膜504を窒化タンタルまたはチタンで50～100nmの厚さに形成し、第2導電膜505をタングステンで100～300nmの厚さに形成する。

【0090】

次に図6(C)に示すように、レジストによるマスク506を形成し、ゲート電極を形成するための第1のエッチング処理を行う。エッチング方法に限定はないが、好適にはICP(Inductively Coupled Plasma:誘導結合型プラズマ)エッチング法を用いる。エッチング用ガスに CF_4 と Cl_2 を混合し、0.5～2Pa、好ましくは1Paの圧力でコイル型の電極に500WのRF(13.56MHz)電力を投入してプラズマを生成して行う。基板側(試料ステージ)にも100WのRF(13.56MHz)電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。 CF_4 と Cl_2 を混合した場合にはタングステン膜、窒化タンタル膜及びチタン膜の場合でも、それぞれ同程度の速度でエッチングすることができる。

【0091】

10

20

30

40

50

上記エッチング条件では、レジストによるマスクの形状と、基板側に印加するバイアス電圧の効果により端部をテーパ形状とすることができる。テーパ部の角度は $15 \sim 45^\circ$ となるようにする。また、ゲート絶縁膜上に残渣を残すことなくエッチングするためには、 $10 \sim 20\%$ 程度の割合でエッチング時間を増加させると良い。W膜に対する酸化窒化シリコン膜の選択比は $2 \sim 4$ （代表的には 3 ）であるので、オーバーエッチング処理により、酸化窒化シリコン膜が露出した面は $20 \sim 50 \text{ nm}$ 程度エッチングされる。こうして、第1のエッチング処理により第1導電膜と第2導電膜から成る第1形状の導電層 507 、 508 （第1の導電層 $507a$ 、 $508a$ と第2導電層 $507b$ 、 $508b$ ）を形成する。 509 はゲート絶縁膜であり、第1の形状の導電層で覆われない領域は $20 \sim 50 \text{ nm}$ 程度エッチングされ薄くなる。

10

【0092】

次いで、レジストマスクをそのままの状態としたまま、図6(D)に示すように第2のエッチング処理を行う。エッチングはICPEッチング法を用い、エッチングガスに CF_4 と Cl_2 と O_2 を混合して、 1 Pa の圧力でコイル型の電極に 500 W のRF電力(13.56 MHz)を供給してプラズマを生成する。基板側（試料ステージ）には 50 W のRF(13.56 MHz)電力を投入し、第1のエッチング処理に比べ低い自己バイアス電圧を印加する。このような条件によりタングステン膜を異方性エッチングし、第1の導電層である窒化タンタル膜またはチタン膜を残存させるようにする。こうして、第2形状の導電層 509 、 510 （第1の導電膜 $509a$ 、 $510a$ と第2の導電膜 $509b$ 、 $510b$ ）を形成する。 511 はゲート絶縁膜であり、第2の形状の導電層 509 、 510 で覆

20

【0093】

そして、第1のドーピング処理を行いn型の不純物（ドナー）をドーピングする。（図7(A)）その方法はイオンドープ法若しくはイオン注入法で行う。n型を付与する不純物元素として15族に属する元素、典型的にはリン（P）または砒素（As）を用いる。この場合、第2形状の導電層 $509b$ 、 $510b$ はドーピングする元素に対してマスクとなり、加速電圧を適宜調節（例えば、 $70 \sim 120 \text{ keV}$ ）して、ゲート絶縁膜 511 及び第2の導電膜 $509a$ 、 $510a$ のテーパ部を通過した不純物元素により不純物領域（n-領域） 512 を形成する。例えば、不純物領域（n-領域）におけるリン（P）濃度は $1 \times 10^{17} \sim 1 \times 10^{19} / \text{cm}^3$ の範囲となるようにする。

30

【0094】

次いで、マスクを除去した後、マスク 513 を形成して図7(B)に示すように第2のドーピング処理を行う。第1のドーピング処理よりもドーズ量を上げ低加速電圧の条件でn型の不純物（ドナー）をドーピングする。例えば、加速電圧を $20 \sim 60 \text{ keV}$ とし、 $1 \times 10^{13} \sim 5 \times 10^{14} / \text{cm}^2$ のドーズ量で行い、不純物領域（n+領域） 514 を形成する。例えば、不純物領域（n+領域）におけるリン（P）濃度は $1 \times 10^{20} \sim 1 \times 10^{21} / \text{cm}^3$ の範囲となるようにする。

【0095】

そして、レジストを除去した後、図7(C)に示すように、レジストによるマスク 515 を形成し、pチャネル型TFTを形成する島状半導体層 501 にp型の不純物（アクセプタ）をドーピングする。典型的にはボロン（B）を用いる。不純物領域（p+領域） 516 、 517 の不純物濃度は $2 \times 10^{20} \sim 2 \times 10^{21} / \text{cm}^3$ となるようにし、含有するリン濃度の $1.5 \sim 3$ 倍のボロンを添加して導電型を反転させる。

40

【0096】

以上までの工程でそれぞれの島状半導体層に不純物領域が形成される。第2形状の導電層 509 、 510 はゲート電極となる。その後、図7(D)に示すように、窒化シリコン膜または酸化窒化シリコン膜から成る保護絶縁膜 518 をプラズマCVD法で形成する。そして導電型の制御を目的としてそれぞれの島状半導体層に添加された不純物元素を活性化

50

する工程を行う。

【0097】

さらに、窒化シリコン膜519を形成し、水素化処理を行う。本実施例では比較的低温で行うことが可能な水素プラズマを用いて水素化処理を行った。

【0098】

層間絶縁膜520は、ポリイミド、アクリルなどの有機絶縁物材料で形成する。勿論、プラズマCVD法でTEOS (Tetraethyl Ortho silicate) を用いて形成される酸化シリコン膜を適用しても良いが、平坦性を高める観点からは前記有機物材料を用いることが望ましい。

【0099】

次いで、コンタクトホールを形成し、アルミニウム (Al)、チタン (Ti)、タンタル (Ta) などを用いて、ソース配線またはドレイン配線521~523を形成する。

【0100】

以上の工程で、nチャネル型TFTとpチャネル型TFTとを相補的に組み合わせたCMOS回路を得ることができる。

【0101】

pチャネル型TFTにはチャネル形成領域524、ソース領域またはドレイン領域として機能する不純物領域516、517を有している。

【0102】

nチャネル型TFTにはチャネル形成領域525、ゲート電極510と重なる不純物領域512a (Gate Overlapped Drain: GOLD領域)、ゲート電極の外側に形成される不純物領域512b (LDD領域)とソース領域またはドレイン領域として機能する不純物領域514を有している。

【0103】

このようなCMOS回路は、アクティブマトリクス型の液晶表示装置の駆動回路を形成することを可能とする。それ以外にも、このようなnチャネル型TFTまたはpチャネル型TFTは、画素部を形成するトランジスタに応用することができる。

【0104】

このようなCMOS回路を組み合わせることで基本論理回路を構成したり、さらに複雑なロジック回路 (信号分割回路、D/Aコンバータ、オペアンプ、補正回路など) をも構成することができ、さらにはメモリやマイクロプロセッサをも形成することが可能である。

【0105】

また、本実施例は実施例1と組み合わせることが可能である。

【実施例5】

【0106】

実施例3に示すnチャネル型TFTは、チャネル形成領域となる半導体に周期表の15族に属する元素 (好ましくはリン) もしくは周期表の13族に属する元素 (好ましくはボロン) を添加することによりエンハンスメント型とデプレッション型とを作り分けることができる。

【0107】

また、nチャネル型TFTを組み合わせる場合、エンハンスメント型TFT同士で形成する場合 (以下、EEMOS回路という) と、エンハンスメント型とデプレッション型とを組み合わせる場合 (以下、EDMOS回路という) がある。

【0108】

ここでEEMOS回路の例を図8(A)に、EDMOS回路の例を図8(B)に示す。図8(A)において、31、32はどちらもエンハンスメント型のnチャネル型TFT (以下、E型NTFTという) である。また、図8(B)において、33はE型NTFT、3

10

20

30

40

50

4 はデプレッション型の n チャンネル型 T F T (以下、D 型 N T F T という) である。

【0109】

なお、図 8 (A)、(B) において、VDH は正の電圧が印加される電源線 (正電源線) であり、VDL は負の電圧が印加される電源線 (負電源線) である。負電源線は接地電位の電源線 (接地電源線) としても良い。

【0110】

さらに、図 8 (A) に示した E E M O S 回路もしくは図 8 (B) に示した E D M O S 回路を用いてシフトレジスタを作製した例を図 9 に示す。図 9 において、40、41 はフリップフロップ回路である。また、42、43 は E 型 N T F T であり、E 型 N T F T 42 のゲートにはクロック信号 (CL) が入力され、E 型 N T F T 43 のゲートには極性の反転したクロック信号 (CLバー) が入力される。また、44 で示される記号はインバータ回路であり、図 9 (B) に示すように、図 8 (A) に示した E E M O S 回路もしくは図 8 (B) に示した E D M O S 回路が用いられる。従って、液晶表示装置の駆動回路を全て n チャンネル型 T F T で構成することも可能である。

10

【0111】

また、本実施例は実施例 1 または実施例 3 と組み合わせることが可能である。

【実施例 6】

【0112】

ここでは、上記実施例 2 ~ 5 で得られる T F T を用いて液晶表示装置を作製した例について図 10 ~ 図 13 を用い、以下に説明する。

20

【0113】

同一の絶縁体上に画素部とそれを駆動する駆動回路を有した液晶表示装置の例 (但し液晶材料封止前の状態) を図 10 に示す。なお、駆動回路には基本単位となる C M O S 回路を示し、画素部には一つの画素を示す。この C M O S 回路及び画素部の T F T は実施例 4 に従えば得ることができる。

【0114】

図 10 において、601 は第 1 固定基板、602 は第 1 接着層、603 は素子形成基板であり、その上には n チャンネル型 T F T 605 と p チャンネル型 T F T 604 からなる駆動回路 608、n チャンネル型 T F T からなる画素 T F T 606 および保持容量 607 とが形成されている。また、本実施例では、T F T はすべてトップゲート型 T F T で形成されている。

30

【0115】

p チャンネル型 T F T 604 と n チャンネル型 T F T 605 の説明は実施例 4 を参照すれば良いので省略する。また、n チャンネル型 T F T からなる画素 T F T 606 の説明は実施例 1 または実施例 3 を参照すればよいので省略する。また、画素 T F T 606 はソース領域およびドレイン領域の間に二つのチャンネル形成領域を有した構造 (ダブルゲート構造) となっているが、実施例 3 での n チャンネル型 T F T の構造の説明を参照すれば容易に理解できるので説明は省略する。なお、本実施例はダブルゲート構造に限定されることなく、チャンネル形成領域が一つ形成されるシングルゲート構造もしくは三つ形成されるトリプルゲート構造であっても良い。

40

【0116】

また、本実施例では、画素 T F T のドレイン領域と接続する画素電極 610 を反射電極とした。その画素電極 610 の材料としては、Al または Ag を主成分とする膜、またはそれらの積層膜等の反射性の優れた材料を用いることが望ましい。また、画素電極 610 を形成した後、公知のサンドブラスト法やエッチング法等の工程を追加して表面を凹凸化させて、鏡面反射を防ぎ、反射光を散乱させることによって白色度を増加させることが好ましい。

【0117】

また、図 12 は、図 10 中の点線 A - A' で切断した断面図である。ゲート電極として機能する導電層 712 は隣接する画素の保持容量の一方の電極を兼ね、画素電極 752 と

50

接続する半導体層 753 と重なる部分で容量を形成している。

また、ソース配線 707 と画素電極 724 及び隣接する画素電極 751 との配置関係は、画素電極 724、751 の端部をソース配線 707 上に設け、重なり部を形成することにより、迷光を遮り遮光性を高めている。

【0118】

図 10 の状態を得た後、画素電極 610 上に配向膜を形成しラビング処理を行う。なお、本実施例では配向膜を形成する前に、アクリル樹脂膜等の有機樹脂膜をパターンニングすることによって基板間隔を保持するための柱状のスペーサ（図示しない）を所望の位置に形成した。また、柱状のスペーサに代えて、球状のスペーサを基板全面に散布してもよい。

10

【0119】

次いで、第 2 固定基板（対向基板）を用意する。次いで、対向基板第 2 固定基板上に着色層、遮光層を形成した後、平坦化膜を形成する。次いで、平坦化膜上に透明導電膜からなる対向電極を少なくとも画素部に形成し、対向基板の全面に配向膜を形成し、ラビング処理を施した。

【0120】

そして、画素部と駆動回路が形成された素子形成基板と第 2 固定基板とを第 2 接着層（本実施例ではシール材）で貼り合わせる。第 2 接着層にはフィラーが混入されていて、このフィラーと柱状スペーサによって均一な間隔を持って 2 枚の基板が貼り合わせられる。その後、両基板の間に液晶材料を注入し、封止剤（図示せず）によって完全に封止する。液晶材料には公知の液晶材料を用いれば良い。

20

【0121】

次いで、液晶の封止（または封入）工程まで行った後、実施の形態および実施例 1 に示したようにレーザー照射により第 1 固定基板を分離した。その後の液晶表示装置の状態について図 11 を用いて説明する。

【0122】

図 11 に示す上面図は、画素部、駆動回路、FPC（フレキシブルプリント配線板：Flexible Printed Circuit）を貼り付ける外部入力端子、外部入力端子と各回路の入力部までを接続する配線 81 などが形成された素子形成基板と、カラーフィルタなどが設けられた対向基板 82 とがシール材 83 を介して貼り合わされている。

30

【0123】

ゲート側駆動回路 84 と重なるように第 2 固定基板側に遮光層 86a が設けられ、ソース側駆動回路 85 と重なるように第 2 固定基板側に遮光層 86b が形成されている。また、画素部 87 上の第 2 固定基板側に設けられたカラーフィルタ 88 は遮光層と、赤色（R）、緑色（G）、青色（B）の各色の着色層とが各画素に対応して設けられている。実際に表示する際には、赤色（R）の着色層、緑色（G）の着色層、青色（B）の着色層の 3 色でカラー表示を形成するが、これら各色の着色層の配列は任意なものとする。

【0124】

ここでは、カラー化を図るためにカラーフィルタ 88 を第 2 固定基板に設けているが特に限定されず、素子形成基板上に素子を作製する際、素子形成基板上にカラーフィルタを形成してもよい。

40

【0125】

また、カラーフィルタにおいて隣り合う画素の間には遮光層が設けられており、表示領域以外の箇所を遮光している。また、ここでは、駆動回路を覆う領域にも遮光層 86a、86b を設けているが、駆動回路を覆う領域は、後に液晶表示装置を電子機器の表示部として組み込む際、カバーで覆うため、特に遮光層を設けない構成としてもよい。また、素子形成基板上に必要な素子を作製する際、素子形成基板に遮光層を形成してもよい。

【0126】

また、上記遮光層を設けずに、第 2 固定基板と対向電極の間に、カラーフィルタを構成する着色層を複数層重ねた積層で遮光するように適宜配置し、表示領域以外の箇所（各画

50

素電極の間隙)や、駆動回路を遮光してもよい。

【0127】

また、外部入力端子にはベースフィルムと配線から成るFPC89が異方性導電性樹脂で貼り合わされている。さらに補強板で機械的強度を高めている。

【0128】

また、第2固定基板のみに偏光板(図示しない)を貼りつける。

【0129】

以上のようにして作製される液晶表示装置は各種電子機器の表示部として用いることができる。

【0130】

また、本実施例は実施例1と組み合わせることが可能である。

【実施例7】

【0131】

本実施例では実施例6に示した液晶表示装置の回路構成例を図13に示す。

【0132】

なお、図13(A)はアナログ駆動を行うための回路構成である。本実施例では、ソース側駆動回路90、画素部91及びゲート側駆動回路92を有している。

なお、本明細書中において、駆動回路とはソース側処理回路およびゲート側駆動回路を含めた総称である。

【0133】

ソース側駆動回路90は、シフトレジスタ90a、バッファ90b、サンプリング回路(トランスファゲート)90cを設けている。また、ゲート側駆動回路92は、シフトレジスタ92a、レベルシフタ92b、バッファ92cを設けている。なお、シフトレジスタ90a、92aとしては図16に示したシフトレジスタを用いれば良い。また、必要であればサンプリング回路とシフトレジスタとの間にレベルシフタ回路を設けてもよい。

【0134】

また、本実施例において、画素部91は複数の画素を含み、その複数の画素に各々TFT素子が設けられている。

【0135】

これらソース側駆動回路90およびゲート側駆動回路92を全てNチャネル型TFTで形成することができる。この場合、全ての回路は図8(A)に示したEEMOS回路を基本単位として形成されている。ただし、従来のCMOS回路に比べると消費電力は若干上がってしまう。

【0136】

また、これらソース側駆動回路90およびゲート側駆動回路92を全てpチャネル型TFTで形成することもできる。

【0137】

なお、図示していないが、画素部91を挟んでゲート側駆動回路92の反対側にさらにゲート側駆動回路を設けても良い。

【0138】

また、デジタル駆動させる場合は、図19(B)に示すように、サンプリング回路の代わりにラッチ(A)93b、ラッチ(B)93cを設ければよい。ソース側駆動回路93は、シフトレジスタ93a、ラッチ(A)93b、ラッチ(B)93c、D/Aコンバータ93d、バッファ93eを設けている。また、ゲート側駆動回路95は、シフトレジスタ95a、レベルシフタ95b、バッファ95cを設けている。なお、シフトレジスタ93a、95aとしては図9に示したシフトレジスタを用いれば良い。また、必要であればラッチ(B)93cとD/Aコンバータ93dとの間にレベルシフタ回路を設けてもよい。

【0139】

また、これらソース側駆動回路93およびゲート側駆動回路95を全てNチャネル型T

10

20

30

40

50

FTで形成することができる。

【0140】

また、これらソース側駆動回路93およびゲート側駆動回路95を全てpチャネル型FTで形成することもできる。

【0141】

なお、上記構成は、上記実施例2、3、または4に示した製造工程に従って実現することができる。また、本実施例では画素部と駆動回路の構成のみ示しているが、本実施例の製造工程に従えば、メモリやマイクロプロセッサをも形成しうる。

【実施例8】

【0142】

本実施例では、画素部及び駆動回路に使用するFTを逆スタガ型FTで構成した液晶表示装置の例を図14に示す。図14(A)は、画素部の画素の一つを拡大した上面図であり、図14(A)において、点線A-A'で切断した部分が、図14(B)の画素部の断面構造に相当する。

【0143】

図14(B)において、50aは第1固定基板、51は第1接着層、50bは素子形成基板であり、まず、実施の形態に従い、第1固定基板50aと第1接着層51(分離層)で貼りつけた素子形成基板50bを用意する。なお、必要があれば素子形成基板上に下地絶縁膜を形成してもよい。

【0144】

画素部において、画素FT部はNチャネル型FTで形成されている。基板上51にゲート電極52が形成され、その上に窒化珪素からなる第1絶縁膜53a、酸化珪素からなる第2絶縁膜53bが設けられている。また、第2絶縁膜上には、活性層としてn+領域54~56と、チャネル形成領域57、58と、前記n+型領域とチャネル形成領域の間にn-型領域59、60が形成される。また、チャネル形成領域57、58は絶縁層61、62で保護される。絶縁層61、62及び活性層を覆う第1の層間絶縁膜63にコンタクトホールを形成した後、n+領域54に接続する配線64が形成され、n+領域56に配線65が接続され、さらにその上にパッシベーション膜66が形成される。そして、その上に第2の層間絶縁膜67が形成される。さらに、その上に第3の層間絶縁膜68が形成され、ITO、SnO₂等の透明導電膜からなる画素電極69が配線65と接続される。また、70は画素電極69と隣接する画素電極である。

【0145】

本実施例では一例として透過型の液晶表示装置の例を示したが特に限定されない。例えば、画素電極の材料として反射性を有する金属材料を用い、画素電極のパターニングの変更、または幾つかの工程の追加/削除を適宜行えば反射型の液晶表示装置を作製することが可能である。

【0146】

なお、本実施例では、画素部の画素FTのゲート配線をダブルゲート構造としているが、オフ電流のバラツキを低減するために、トリプルゲート構造等のマルチゲート構造としても構わない。また、開口率を向上させるためにシングルゲート構造としてもよい。

【0147】

また、画素部の容量部は、第1絶縁膜及び第2絶縁膜を誘電体として、容量配線71と、n+領域56とで形成されている。

【0148】

なお、図14で示した画素部はあくまで一例に過ぎず、特に上記構成に限定されないことはいうまでもない。

【0149】

また、素子形成基板上の全てのFTをNチャネル型FTとすることができる。素子形成基板上の全てのFTをNチャネル型FTで構成すれば、Pチャネル型FTを形成する工程を省略できるため、液晶表示装置の製造工程を簡略化することができる。また

10

20

30

40

50

、それに伴って製造工程の歩留まりが向上し、液晶表示装置の製造コストを下げるができる。

【実施例 9】

【0150】

本実施例では、画素部及び駆動回路に使用する T F T を全て N チャンネル型 T F T で構成した液晶表示装置の例を図 15 に示す。なお、実施例 6 の図 10 と同一である箇所に相当するところは同じ符号を用いた。

【0151】

図 15 において、601 は第 1 固定基板、602 は第 1 接着層、603 は素子形成基板であり、まず、実施の形態に従い、第 1 固定基板 601 と第 1 接着層 602 (分離層) で貼りつけた素子形成基板 603 上に下地絶縁膜を形成する。

10

【0152】

下地絶縁膜上には N チャンネル型 T F T 1101、N チャンネル型 T F T 1102 からなる駆動回路、N チャンネル型 T F T からなる画素 T F T 1103 および保持容量 1104 が形成されている。なお、N チャンネル型 T F T の説明は実施例 3 を参照すれば良いので省略する。

【0153】

ここでは、実施例 6 とは異なり、透過型の液晶表示装置の例である。層間絶縁膜を形成した後、透明導電膜からなる画素電極 1107 をパターニングにより形成した後、コンタクトホールを形成して画素電極 1107 と画素 T F T 1103 のドレイン領域とを接続する接続電極 1108 を形成した。また、同様にして画素電極 1107 と保持容量 1104 における半導体領域とを接続する接続電極 1109 を形成した。

20

【0154】

また、図 15 の状態を得た後、実施例 6 の工程に従って、第 2 接着層で第 2 固定基板を貼り合わせた後、第 1 接着層 602 にレーザーを照射して第 1 固定基板 601 を分離して、液晶表示装置を完成させればよい。

【0155】

N チャンネル型 T F T のみでゲート側駆動回路およびソース側駆動回路を形成することにより画素部および駆動回路をすべて N チャンネル型 T F T で形成することが可能となる。従って、アクティブマトリクス型の電気光学装置を作製する上で T F T 工程の歩留まりおよびスループットを大幅に向上させることができ、製造コストを低減することが可能となる。

30

【0156】

なお、ソース側駆動回路もしくはゲート側駆動回路のいずれか片方を外付けの I C チップとする場合にも本実施例は実施できる。

【0157】

また、本実施例では、E 型 N T F T のみを用いて駆動回路を構成したが E 型 N T F T および D 型 N T F T を組み合わせて形成してもよい。

【実施例 10】

【0158】

本実施例では、画素部及び駆動回路に使用する T F T を全て P チャンネル型 T F T で構成した液晶表示装置の例を図 16 に示す。なお、実施例 6 の図 10 と同一である箇所に相当するところは同じ符号を用いた。

40

【0159】

図 16 において、601 は第 1 固定基板、602 は第 1 接着層、603 は素子形成基板であり、まず、実施の形態に従い、第 1 固定基板 601 と第 1 接着層 602 (分離層) で貼りつけた素子形成基板 603 上に下地絶縁膜を形成する。

【0160】

下地絶縁膜上には P チャンネル型 T F T 1201、P チャンネル型 T F T 1202 からなる駆動回路、P チャンネル型 T F T からなる画素 T F T 1203 および保持容量 1204 が形

50

成されている。なお、Pチャネル型TFTの説明は実施例2を参照すれば良いので省略する。

【0161】

ここでは、実施例6とは異なり、透過型の液晶表示装置の例である。層間絶縁膜を形成した後、透明導電膜からなる画素電極1207をパターニングにより形成した後、コンタクトホールを形成して画素電極1207と画素TFT1203のドレイン領域とを接続する接続電極1208を形成した。また、同様にして画素電極1207と保持容量1204における半導体領域とを接続する接続電極1209を形成した。

【0162】

また、図16の状態を得た後、実施例6の工程に従って、第2接着層で第2固定基板を貼り合わせた後、第1接着層602にレーザーを照射して第1固定基板601を分離して、液晶表示装置を完成させればよい。

10

【0163】

Pチャネル型TFTのみでゲート側駆動回路およびソース側駆動回路を形成することにより画素部および駆動回路をすべてPチャネル型TFTで形成することが可能となる。従って、アクティブマトリクス型の電気光学装置を作製する上でTFT工程の歩留まりおよびスループットを大幅に向上させることができ、製造コストを低減することが可能となる。

【0164】

なお、ソース側駆動回路もしくはゲート側駆動回路のいずれか片方を外付けのICチップとする場合にも本実施例は実施できる。

20

【実施例11】

【0165】

素子形成基板としては、金属基板、例えばステンレス基板を用いることもできる。本実施例は、その場合の例を以下に示す。

【0166】

本実施例では、実施例1の素子形成基板として、ステンレス基板(厚さ10~200 μ m)を用いる。まず、実施の形態に従って第1固定基板とステンレス基板とを第1接着層で貼り合わせる。

【0167】

以降は、実施例1に従って、ステンレス基板からなる素子形成基板上に下地絶縁膜を形成して必要な素子を形成すればよい。なお、実施例1とは異なり、耐熱性が高いステンレス基板を用いているため、実施例1よりも高い温度(約500以下)でのプロセスを使用してTFTを作製することができる。

30

【0168】

そして、第1固定基板を分離する際、ステンレス基板を用いているため、レーザー光を照射しても素子形成基板上に形成された素子に全く影響を与えることなく第1固定基板を分離することができる。

【0169】

また、ステンレス基板は遮光性を有しているため、本実施例の表示装置は、反射型の液晶表示装置となる。

40

【0170】

薄い金属基板(厚さ10~200 μ m)を用いることによって軽量化、薄型化が図れるとともに可撓性を有する発光装置を得ることができる。また、金属基板を用いているため、素子基板上に形成されたTFT素子の放熱効果が得られる。

【0171】

また、本実施例は、実施例1乃至9のいずれか一と自由に組み合わせることが可能である。

【実施例12】

【0172】

50

本願発明を実施して形成された駆動回路や画素部は様々な電気光学装置（アクティブマトリクス型液晶ディスプレイ、アクティブマトリクス型ELディスプレイ、アクティブマトリクス型ECディスプレイ）に用いることができる。即ち、それら電気光学装置を表示部に組み込んだ電子機器全てに本願発明を実施できる。

【0173】

その様な電子機器としては、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ヘッドマウントディスプレイ（ゴーグル型ディスプレイ）、カーナビゲーション、カーステレオ、パーソナルコンピュータ、携帯情報端末（モバイルコンピュータ、携帯電話または電子書籍等）などが挙げられる。それらの一例を図18及び図19に示す。

【0174】

図18（A）はパーソナルコンピュータであり、本体2001、画像入力部2002、表示部2003、キーボード2004等を含む。本発明を画像入力部2002、表示部2003やその他の駆動回路に適用することができる。

【0175】

図18（B）はビデオカメラであり、本体2101、表示部2102、音声入力部2103、操作スイッチ2104、バッテリー2105、受像部2106等を含む。本発明を表示部2102やその他の駆動回路に適用することができる。

【0176】

図18（C）はモバイルコンピュータ（モビルコンピュータ）であり、本体2201、カメラ部2202、受像部2203、操作スイッチ2204、表示部2205等を含む。本発明は表示部2205やその他の駆動回路に適用できる。

【0177】

図18（D）はゴーグル型ディスプレイであり、本体2301、表示部2302、アーム部2303等を含む。本発明は表示部2302やその他の駆動回路に適用することができる。

【0178】

図18（E）はプログラムを記録した記録媒体（以下、記録媒体と呼ぶ）を用いるプレーヤーであり、本体2401、表示部2402、スピーカ部2403、記録媒体2404、操作スイッチ2405等を含む。なお、このプレーヤーは記録媒体としてDVD（Digital Versatile Disc）、CD等を用い、音楽鑑賞や映画鑑賞やゲームやインターネットを行うことができる。本発明は表示部2402やその他の駆動回路に適用することができる。

【0179】

図18（F）はデジタルカメラであり、本体2501、表示部2502、接眼部2503、操作スイッチ2504、受像部（図示しない）等を含む。本願発明を表示部2502やその他の駆動回路に適用することができる。

【0180】

図19（A）は携帯電話であり、本体2901、音声出力部2902、音声入力部2903、表示部2904、操作スイッチ2905、アンテナ2906等を含む。本願発明を音声出力部2902、音声入力部2903、表示部2904やその他の駆動回路に適用することができる。

【0181】

図19（B）は携帯書籍（電子書籍）であり、本体3001、表示部3002、3003、記憶媒体3004、操作スイッチ3005、アンテナ3006等を含む。本発明は表示部3002、3003やその他の駆動回路に適用することができる。

【0182】

図19（C）はディスプレイであり、本体3101、支持台3102、表示部3103等を含む。本発明は表示部3103に適用することができる。本発明のディスプレイは特に大画面化した場合において有利であり、対角10インチ以上（特に30インチ以上）のディスプレイには有利である。

10

20

30

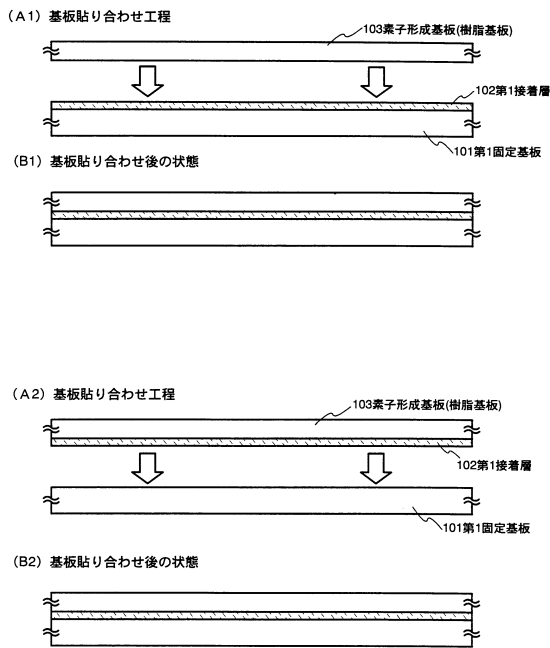
40

50

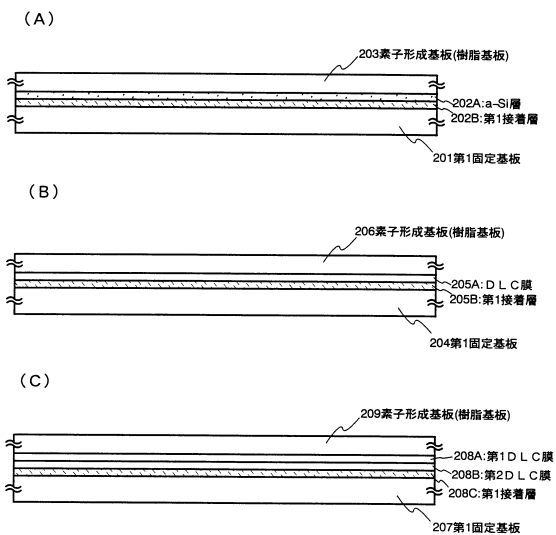
【 0 1 8 3 】

以上の様に、本願発明の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電子機器に適用することが可能である。また、本実施例の電子機器は実施例 1 ~ 1 0 のどのような組み合わせからなる構成を用いても実現することができる。

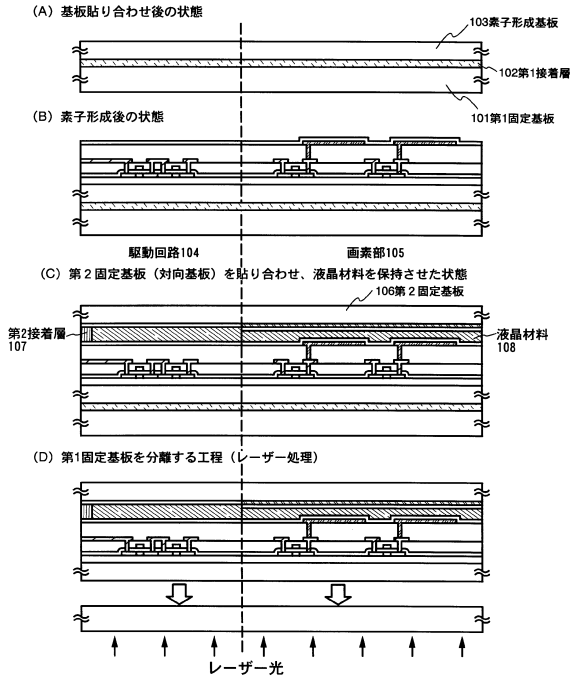
【 図 1 】



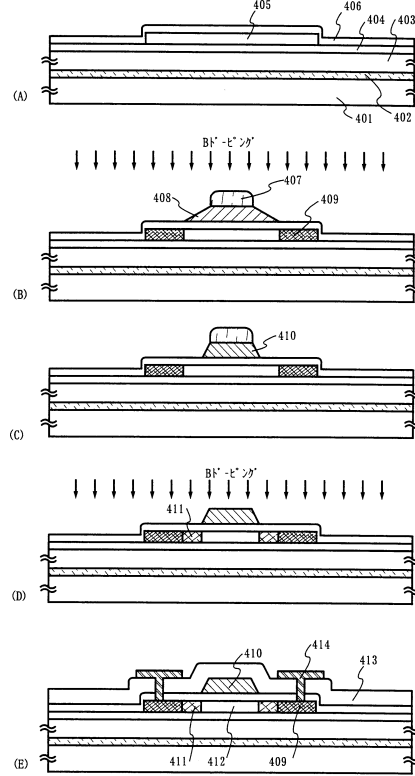
【 図 2 】



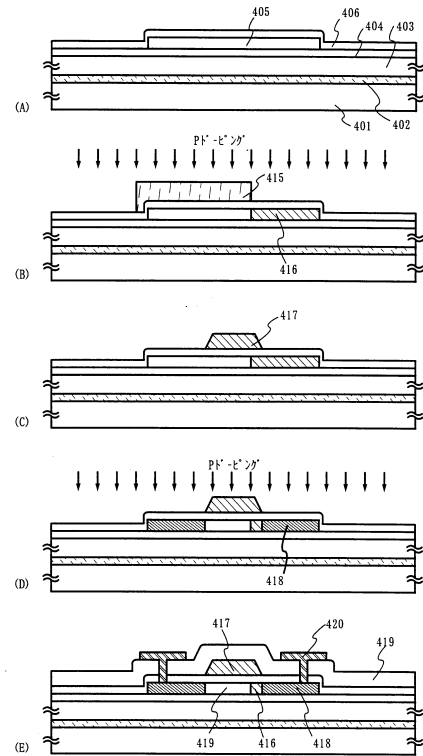
【図3】



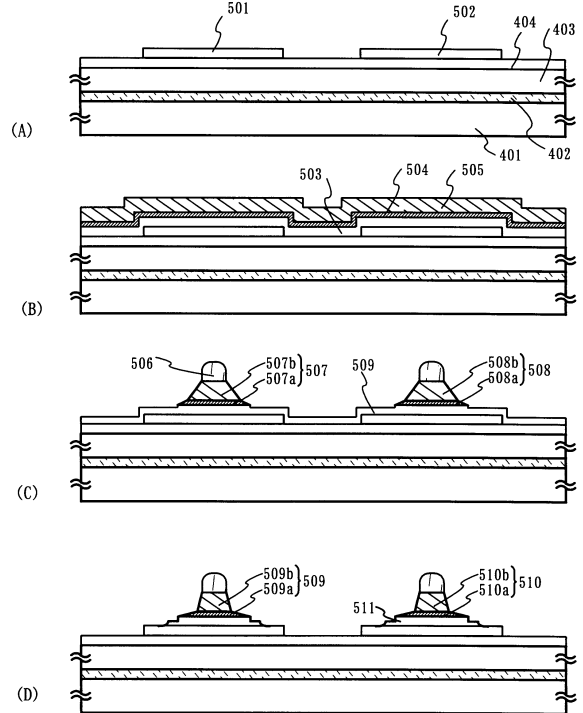
【図4】



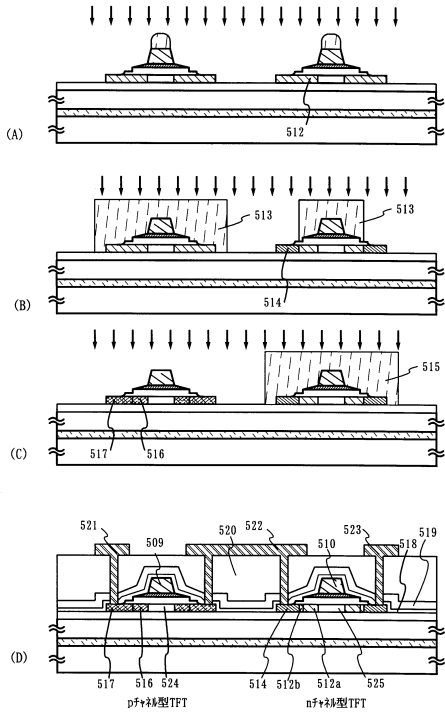
【図5】



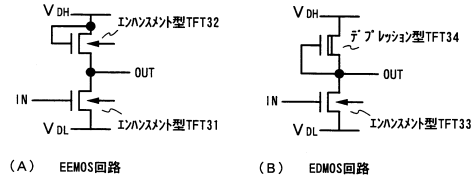
【図6】



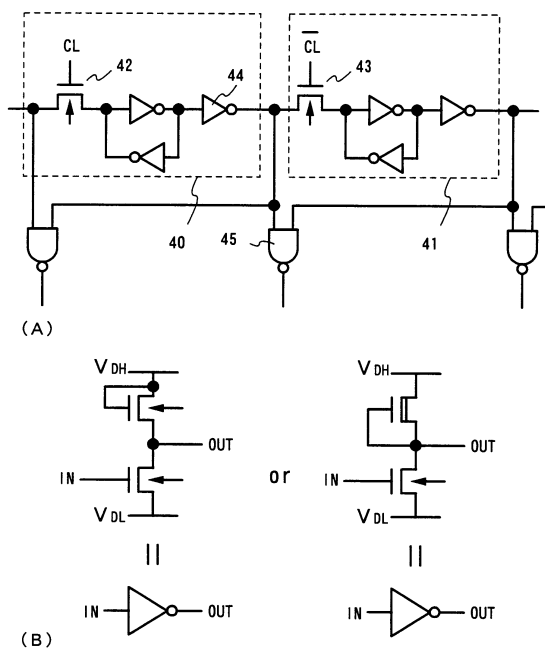
【図7】



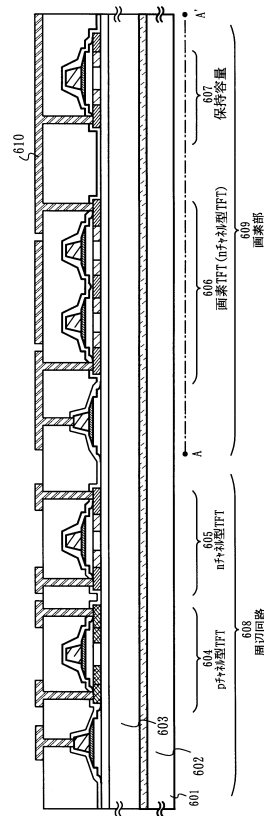
【図8】



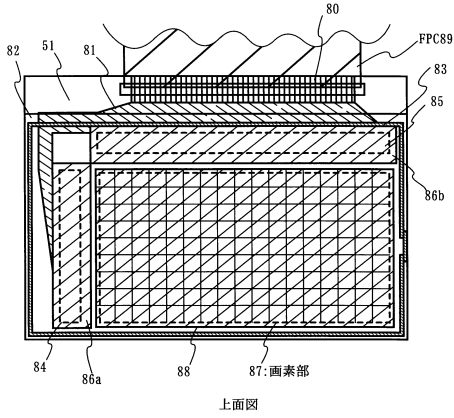
【図9】



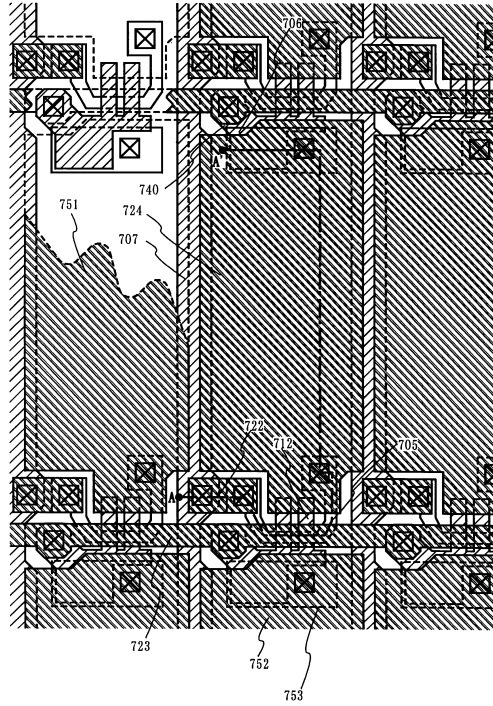
【図10】



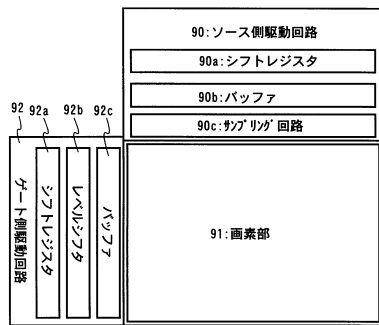
【図11】



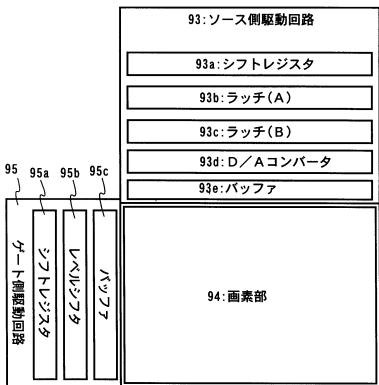
【図12】



【図13】

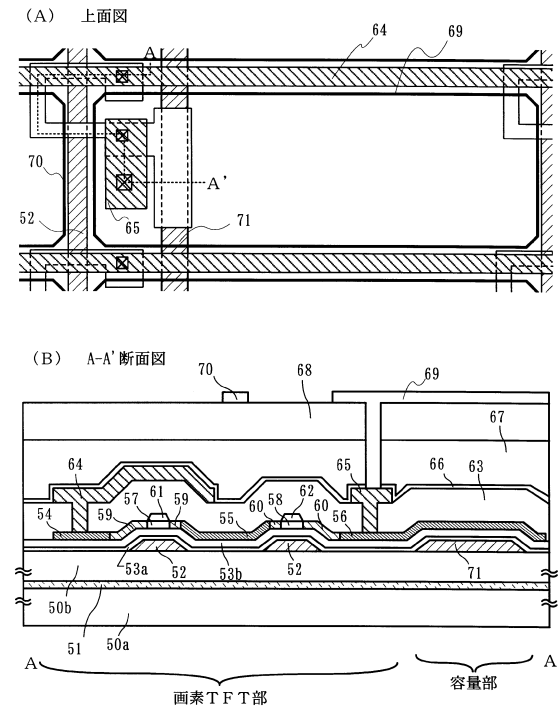


(A)

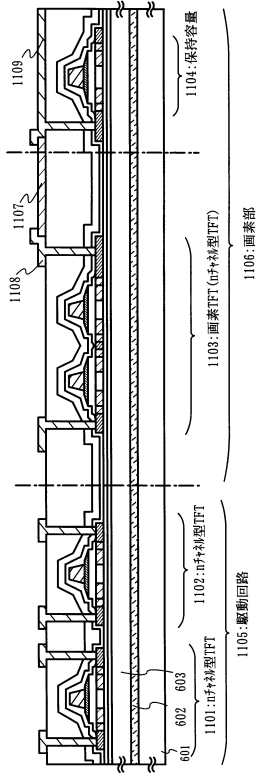


(B)

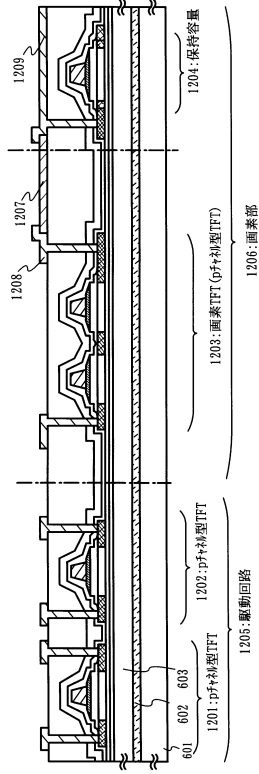
【図14】



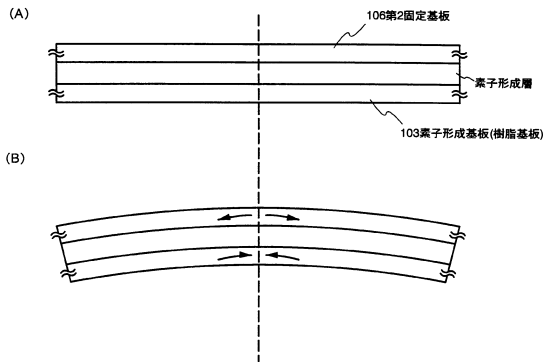
【図15】



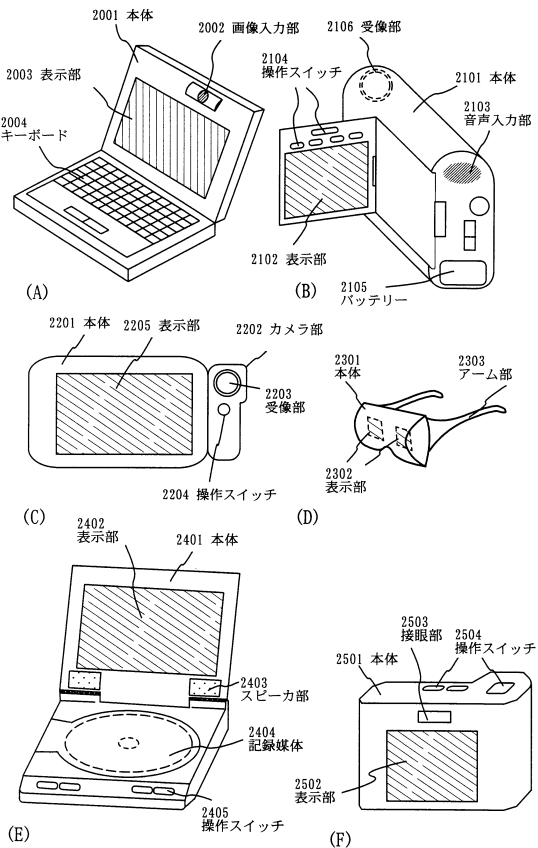
【図16】



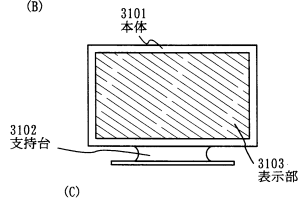
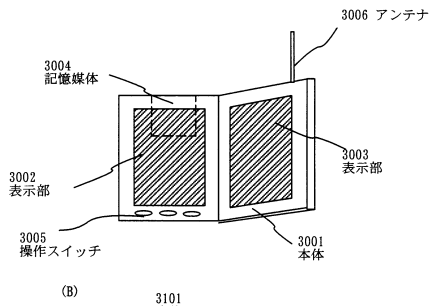
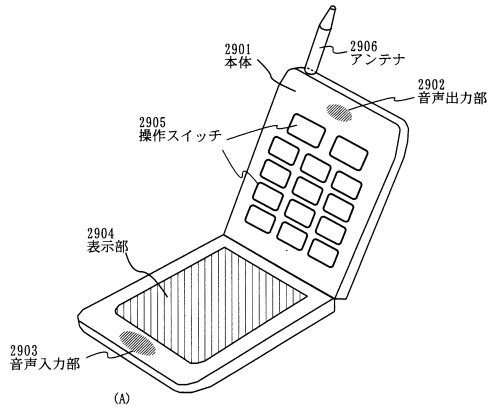
【図17】



【図18】



【図19】



フロントページの続き

- (56)参考文献 特開2001-267578(JP,A)
特開平11-074533(JP,A)
特開平11-312811(JP,A)
特開平10-125929(JP,A)
特開平10-125931(JP,A)
特開平09-105896(JP,A)
特開平08-288522(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

G02F	1/1368
G09F	9/00
G09F	9/30
H01L	21/336
H01L	29/786